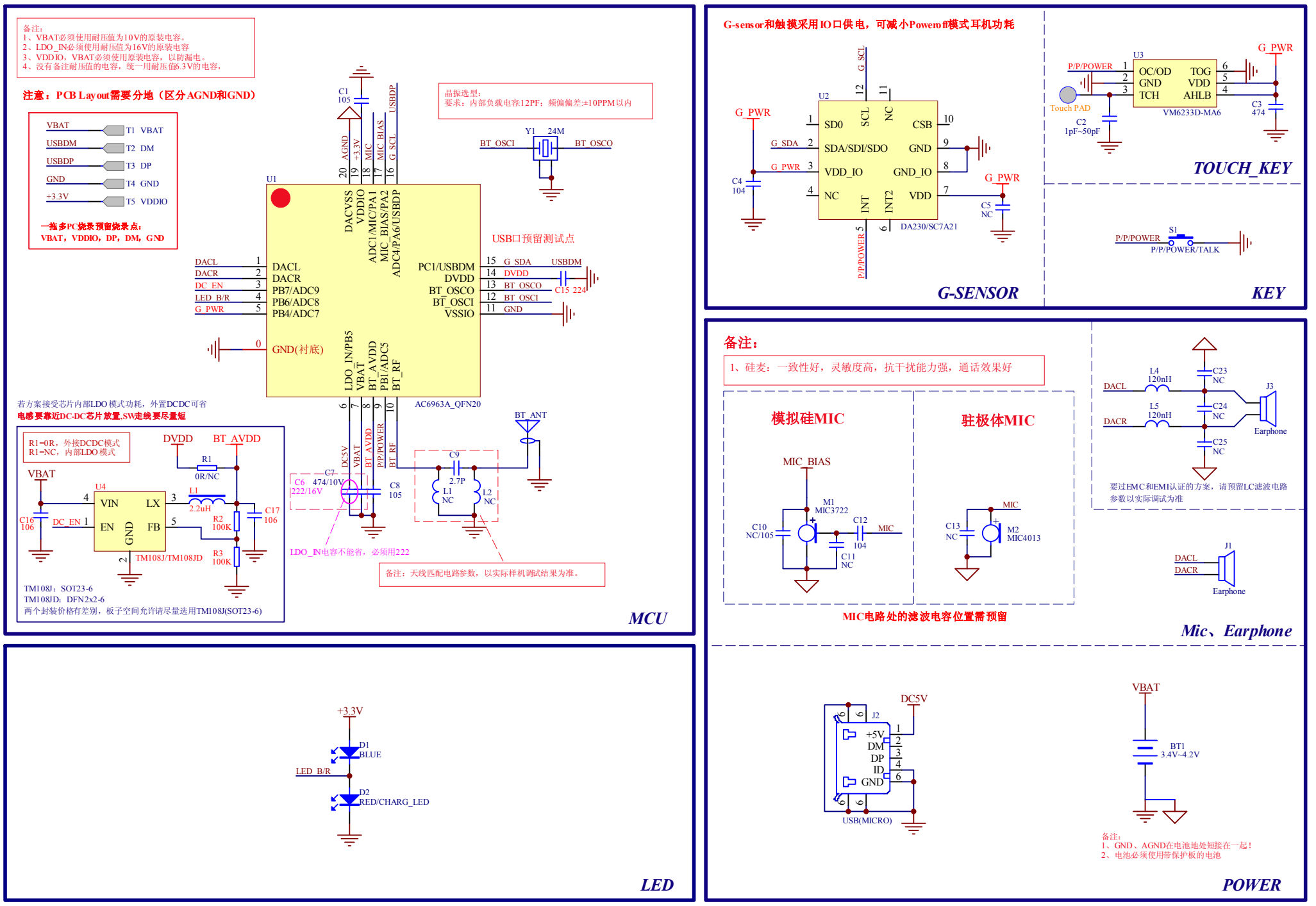

备注：
1、VBAT必须使用耐压值为10V的原装电容。
2、LDO_IN必须使用耐压值为16V的原装电容
3、VDDIO，VBAT必须使用原装电容，以防漏电。
4、没有备注耐压值的电容，统一用耐压值6.3V的电容，
注意：PCB Layout需要分地（区分AGND和GND）
VBAT T1 VBAT
USBDM T2 DM
USBDP T3 DP
GND T4 GND
+3.3V T5 VDDIO
一拖多PC烧录预留烧录点：
VBAT，VDDIO，DP，DM，GND
晶振选型：
要求：内部负载电容12PF；频偏偏差:±10PPM以内
Y1 24M
BT_OSCI
BT_OSCO
USB口预留测试点
U1
DACL
DACR
PB7/ADC9
PB6/ADC8
PB4/ADC7
GND(衬底)
DACVSS
VDDIO
ADC1/MIC/PA1
MIC_BIAS/PA2
ADC4/PA6/USBDP
PC1/USBDM
DVDD
BT_OSCO
BT_OSCI
VSSIO
LDO_IN/PB5
VBAT
BT_AVDD
PB1/ADC5
BT_RF
AC6963A_QFN20
若方案接受芯片内部LDO模式功耗，外置DCDC可省
电感要靠近DC-DC芯片放置,SW走线要尽量短
R1=0R，外接DCDC模式
R1=NC，内部LDO模式
TM108J：SOT23-6
TM108JD：DFN2x2-6
两个封装价格有差别，板子空间允许请尽量选用TM108J(SOT23-6)
LDO_IN电容不能省，必须用222
备注：天线匹配电路参数，以实际样机调试结果为准。
MCU
G-sensor和触摸采用IO口供电，可减小Poweroff模式耳机功耗
U2
SD0
SDA/SDI/SDO
VDD_IO
NC
CSB
GND
GND_IO
VDD
DA230/SC7A21
G_PWR
G_SDA
G_SCL
P/P/POWER
G-SENSOR
U3
OC/OD
GND
TCH
TOG
VDD
AHLB
VM6233D-MA6
Touch PAD
TOUCH_KEY
S1
P/P/POWER/TALK
KEY
备注：
1、硅麦：一致性好，灵敏度高，抗干扰能力强，通话效果好
模拟硅MIC
MIC_BIAS
M1
MIC3722
驻极体MIC
M2
MIC4013
MIC电路处的滤波电容位置需预留
L4
120nH
L5
120nH
J3
Earphone
要过EMC和EMI认证的方案，请预留LC滤波电路
参数以实际调试为准
J1
Mic、Earphone
+3.3V
D1
BLUE
D2
RED/CHARG_LED
LED_B/R
LED
DC5V
J2
+5V
DM
DP
ID
GND
USB(MICRO)
VBAT
BT1
3.4V~4.2V
备注：
1、GND、AGND在电池地处短接在一起！
2、电池必须使用带保护板的电池
POWER